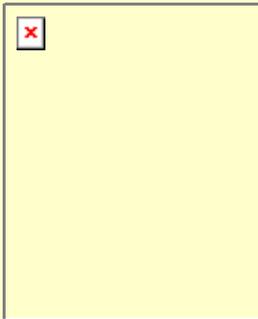


## 本期封面



2002年10期

栏目:

DOI:

论文题目: 磁场退火对CoFeNiNbSiB薄带巨磁阻抗的影响

作者姓名: 吴厚政 刘宜华 代由勇 张林 萧淑琴

工作单位: 山东大学物理与微电子学院, 济南250100

通信作者: 吴厚政

通信作者Email: [yhliu@sdu.edu.cn](mailto:yhliu@sdu.edu.cn)

文章摘要: 本文研究了磁场退火对CoFeNiNbSiB非晶薄带巨磁阻抗(GMI)效应的影响样品在不同条件下进行了退火热处理. 结果表明, 在300℃下经横向磁场退火处理后获得了最佳的软磁特性, 从而得到了最大的GMI效应. 在800 kHz的交变电流频率下, 得到了236%的最大磁阻抗比. 在低场下, 材料的磁阻抗磁场灵敏度达到1152%/mT.

关键词: 巨磁阻抗效应, 非晶态软磁钴基合金薄带

分类号: TG139

关闭